


**Netz-Thyristor-Modul**  
**Phase Control Thyristor Module**
**TZ530N**
**TZ530N**
**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	3000 3400	3200 3600	V V
Vorwärts-Stoßspitzenspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	$V_{\text{DSM}}$	3000 3400	3200 3600	V V
Rückwärts-Stoßspitzenspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	$V_{\text{RSM}}$	3100 3500	3300 3700	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		$I_{\text{TRMSM}}$		1500	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}} = 30^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TAVM}}$		530 955	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I_{\text{TSM}}$		22.000 20.000	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2t$		2.420.000 2.000.000	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50 \text{ Hz}, i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$		80	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6.Kennbuchstabe / 6 <sup>th</sup> letter C 6.Kennbuchstabe / 6 <sup>th</sup> letter F	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$		500 1000	$\text{V}/\mu\text{s}$ $\text{V}/\mu\text{s}$

## Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, i_{\text{T}} = 3000 \text{ A}$	$V_{\text{T}}$	max.	2,65	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}$	$V_{(\text{TO})}$		1,05	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj \max}$	$r_{\text{T}}$		0,49	$\text{m}\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6 \text{ V}$	$I_{\text{GT}}$	max.	250	$\text{mA}$
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6 \text{ V}$	$V_{\text{GT}}$	max.	2	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 6 \text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$I_{\text{GD}}$	max. max.	10 5	$\text{mA}$ $\text{mA}$
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$V_{\text{GD}}$	max.	0,25	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6 \text{ V}, R_{\text{A}} = 5 \Omega$	$I_{\text{H}}$	max.	500	$\text{mA}$
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6 \text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10 \Omega$ $i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}, t_{\text{g}} = 20 \mu\text{s}$	$I_{\text{L}}$	max.	2500	$\text{mA}$
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	$T_{vj} = T_{vj \max}$ $V_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max.	250	$\text{mA}$
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	$t_{\text{gd}}$	max.	4	$\mu\text{s}$

prepared by:	C.Drilling	date of publication:	06.03.03
approved by:	J. Novotny	revision:	1


**Netz-Thyristor-Modul**  
**Phase Control Thyristor Module**
**TZ530N**
**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**


Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\max}$ , $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}$ , $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$ , $-di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ 5.Kennbuchstabe / 5 <sup>th</sup> letter O	$t_q$	typ.	400	$\mu\text{s}$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}$ , $t = 1\text{ min}$ RMS, $f = 50\text{ Hz}$ , $t = 1\text{ sec}$	$V_{ISOL}$		3,0 3,6	kV kV

**Thermische Eigenschaften / Thermal properties**

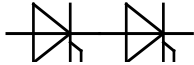
Innere Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ\text{ sin}$ pro Modul / per Module, DC	$R_{thJC}$	max.	0,0450	$^\circ\text{C}/\text{W}$
			max.	0,0435	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module	$R_{thCH}$	max.	0,01	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\max}$		125	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$		-40...+125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$		-40...+130	$^\circ\text{C}$

**Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties**

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Innere Isolation internal insulation				AIN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse mounting torque	Toleranz / Tolerance $\pm 15\%$	M1		6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / Tolerance $\pm 10\%$	M2		18	Nm
Steueranschlüsse control terminals	DIN 46 244			A 2,8 x 0,8	
Gewicht weight		G	typ.	2750	g
Kriechstrecke creepage distance				36	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50\text{ Hz}$			50	$\text{m}/\text{s}^2$
	file-No.			E 83336	

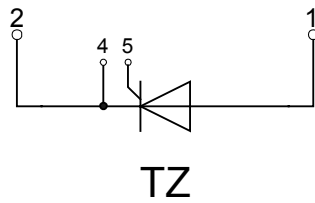
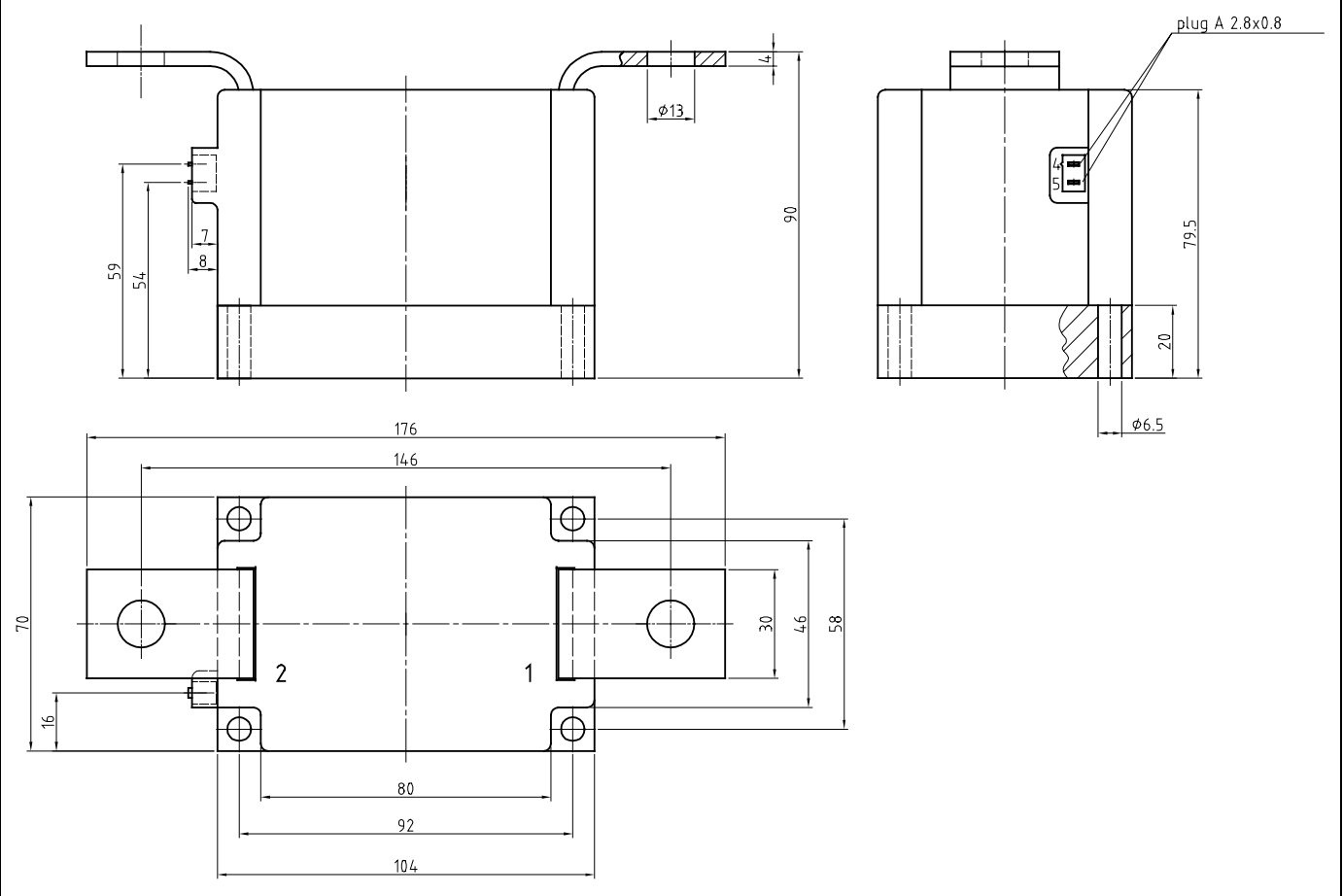
Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Es gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



**Netz-Thyristor-Modul**  
Phase Control Thyristor Module

**TZ530N**





Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

**TZ530N**

**Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  für DC**  
**Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  for DC**

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn}$ [°C/W]	0,0011	0,00275	0,00942	0,023157	0,00721		
$\tau_n$ [s]	0,01	0,0188	0,30347	4,994	9,98		

Analytische Funktion / Analytical function: 
$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

Verstärkte Kühlung / Forced cooling  
1 Modul pro Kühlkörper / 1 module per heatsink  
Kühlkörper / Heatsink type: KW 70 (4l/min)

**Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thCA}$**   
**Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thCA}$**

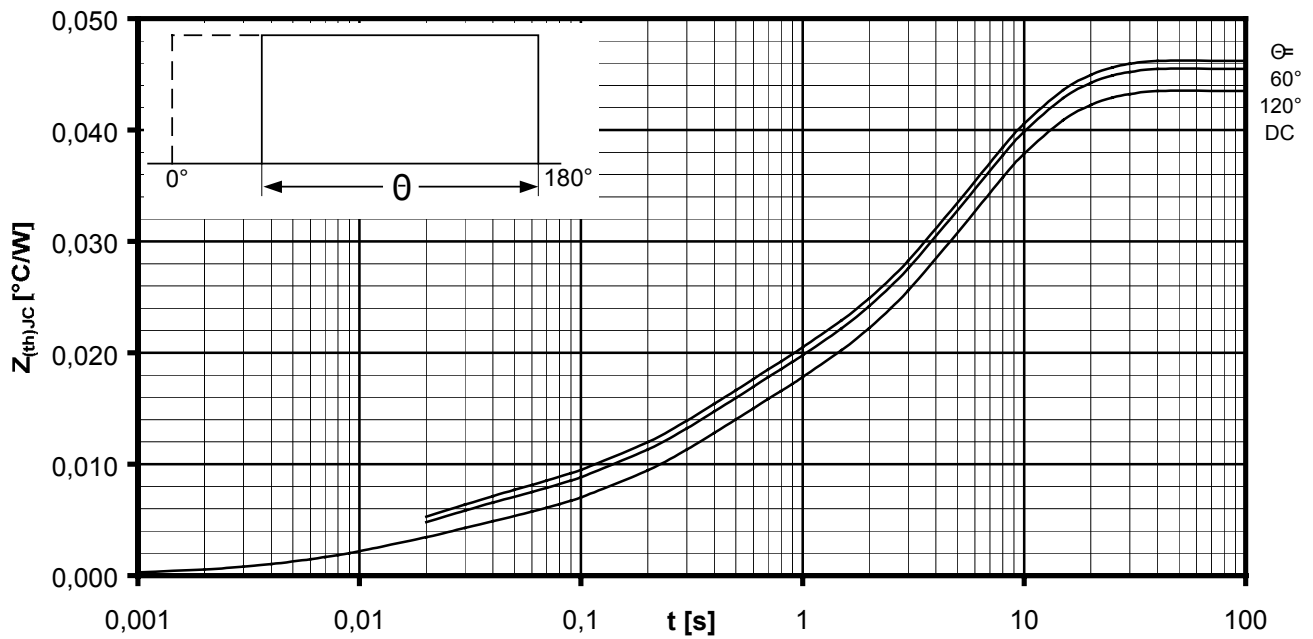
Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn}$ [°C/W]	0,00214	0,00035	0,0245				
$\tau_n$ [s]	9,89	13	31,3				

Analytische Funktion / Analytical function: 
$$Z_{thCA} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$



Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

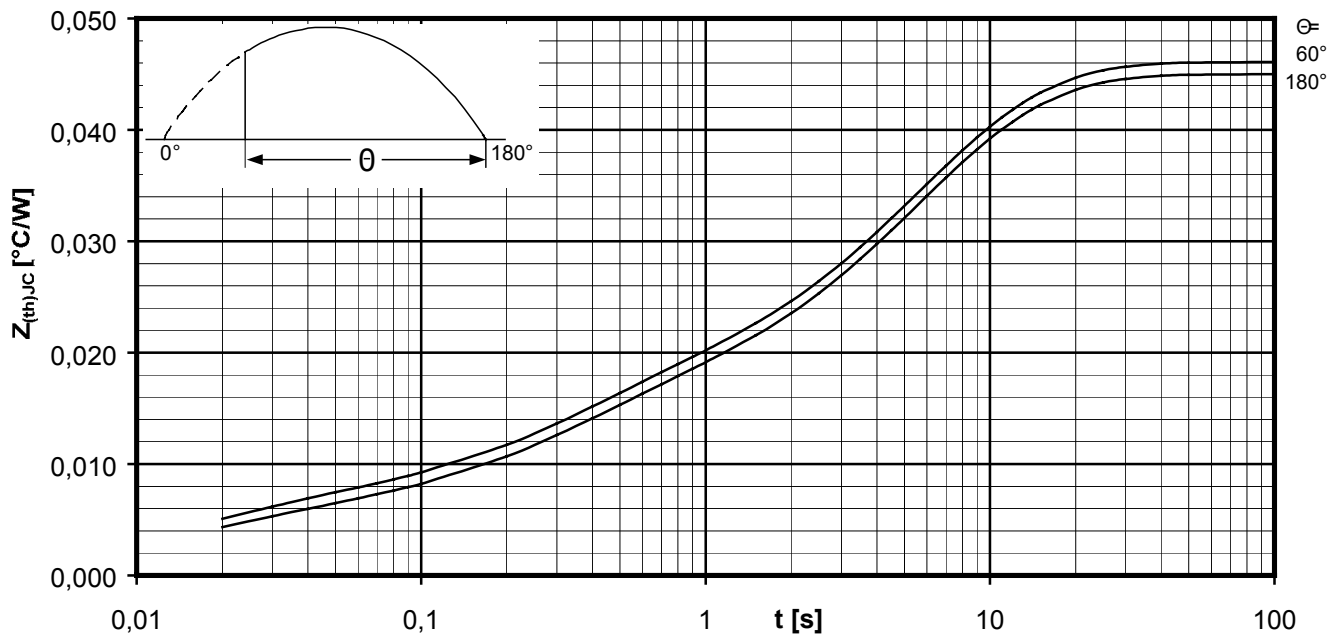
**TZ530N**



Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm  $Z_{thJC} = f(t)$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current

Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / Current conduction angle  $\Theta$



Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm  $Z_{thJC} = f(t)$

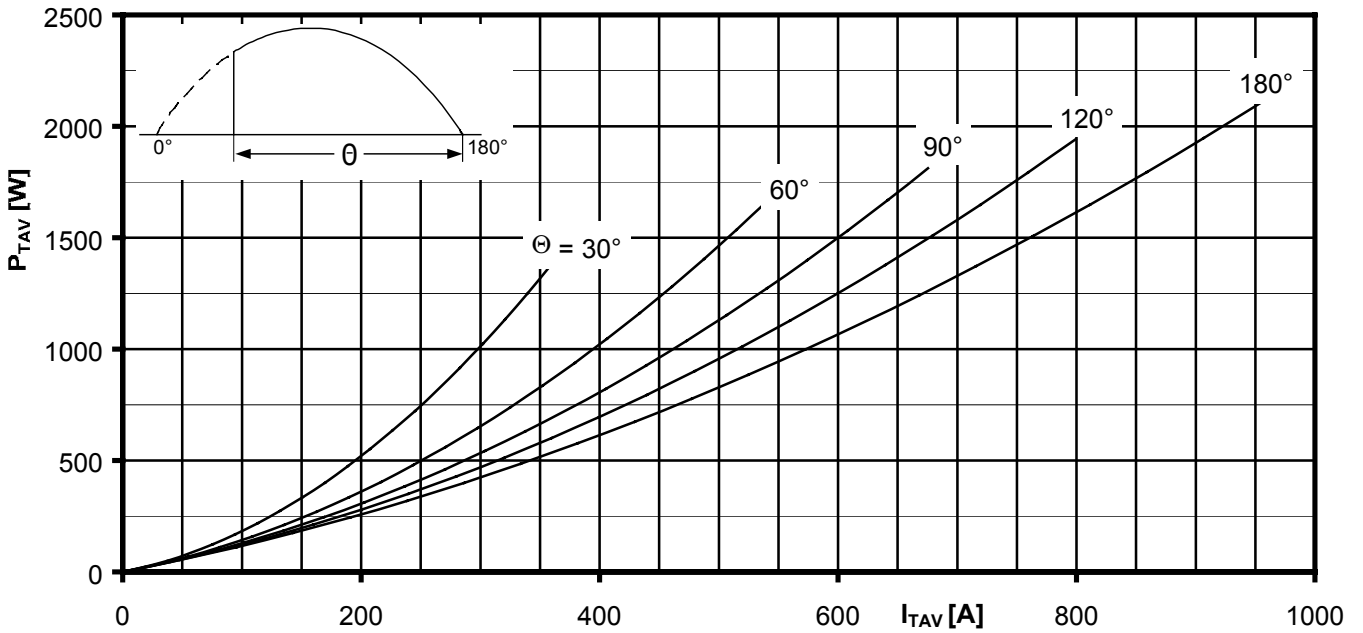
Rechteckförmiger Strom / Rectangular current

Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / Current conduction angle  $\Theta$



**Netz-Thyristor-Modul**  
Phase Control Thyristor Module

**TZ530N**

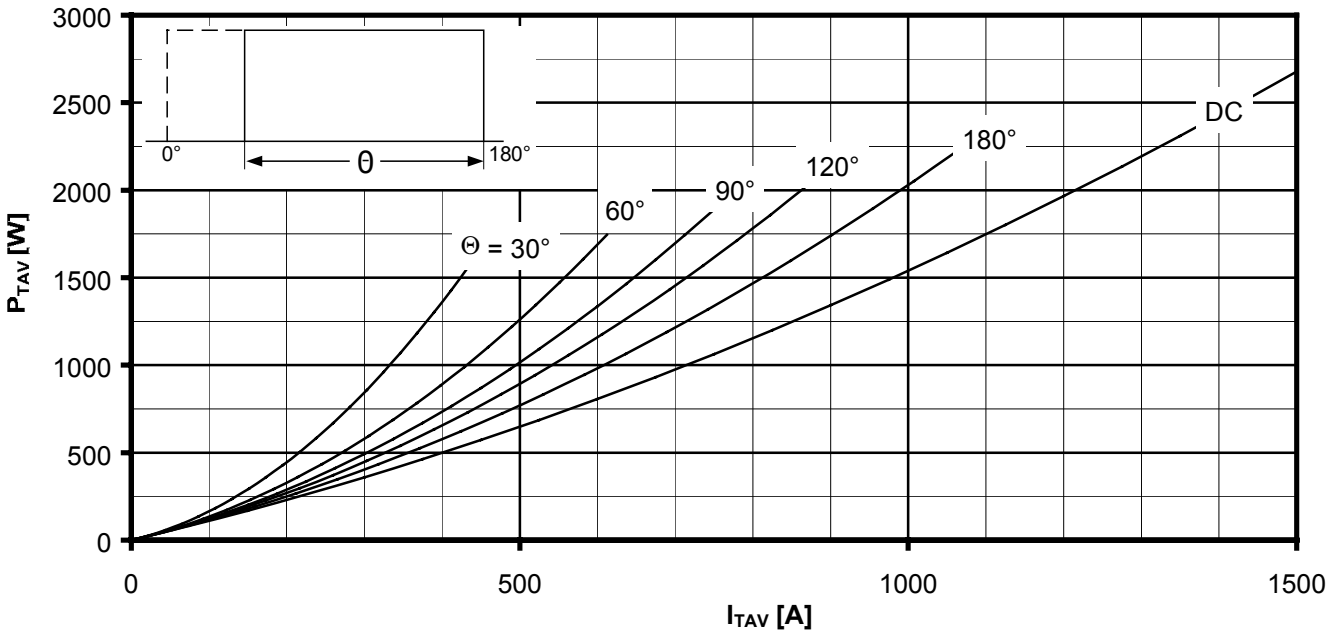


**Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$**

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current    Strombelastung je Zweig / Current load per arm

**Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)**  
**Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)**

Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\Theta$



**Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$**

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current    Strombelastung je Zweig / Current load per arm

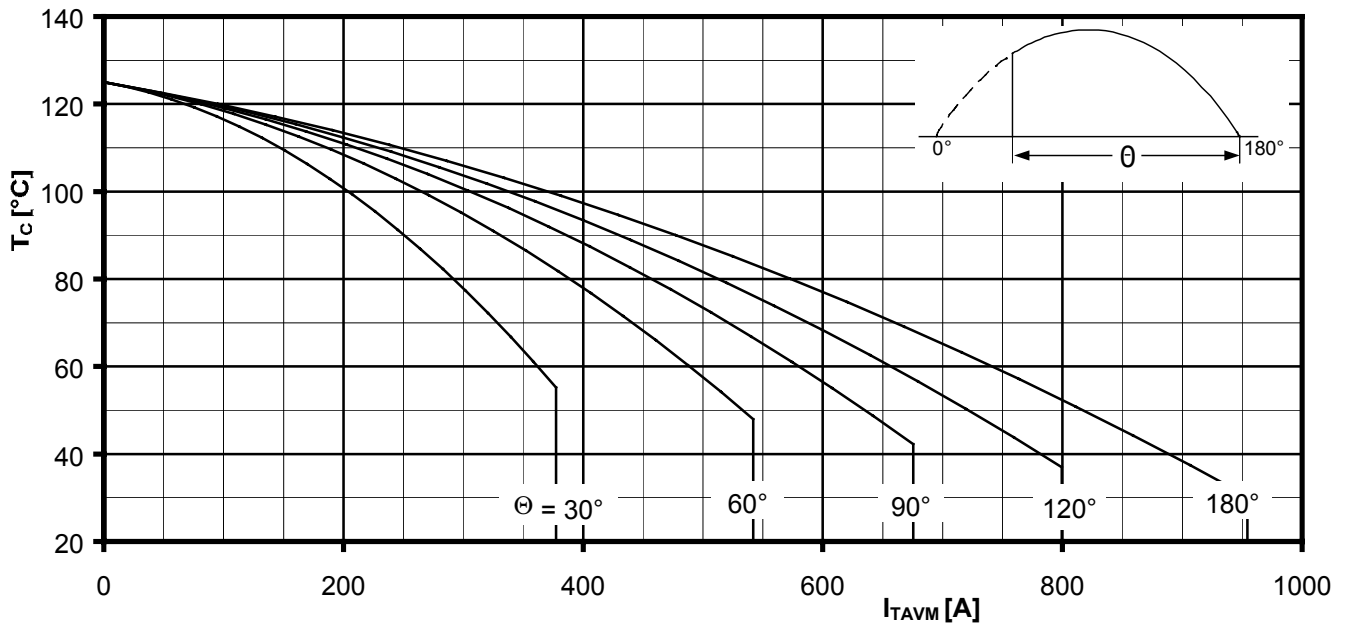
**Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)**  
**Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)**

Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\Theta$



Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

**TZ530N**

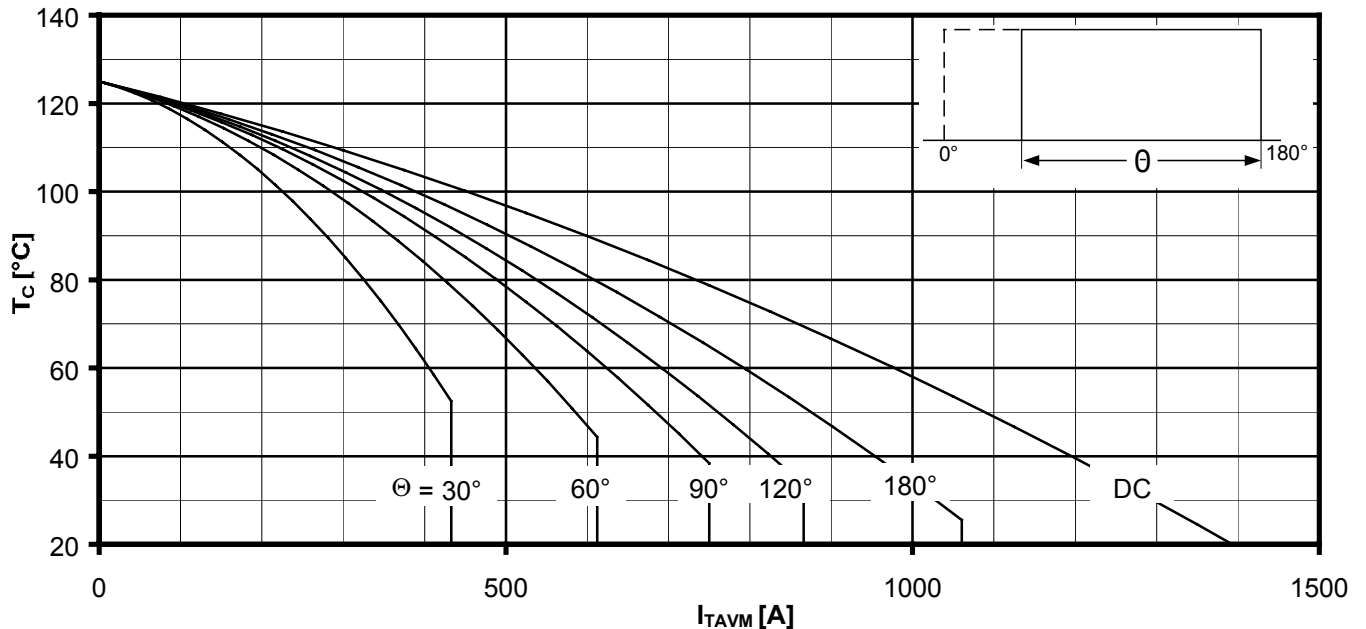


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_C = f(I_{TAVM})$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

**Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)**  
**Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)**

Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / Current conduction angle  $\Theta$



Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_C = f(I_{TAVM})$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

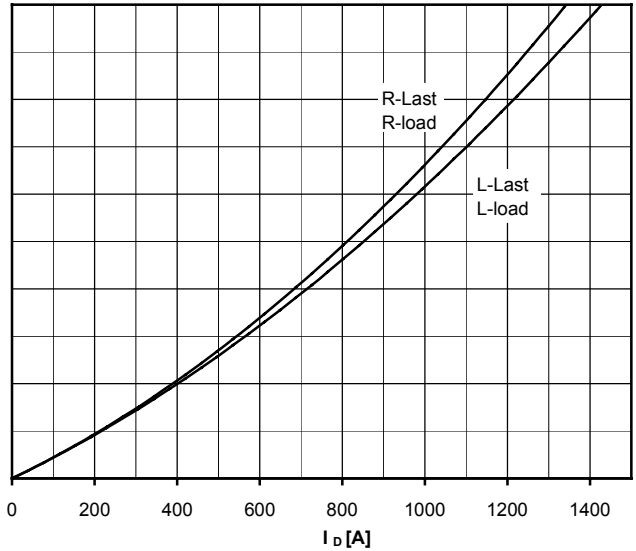
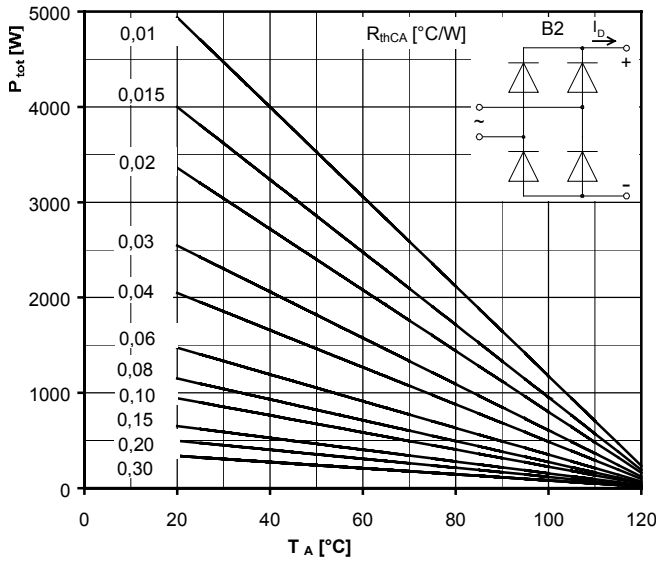
**Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)**  
**Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)**

Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / Current conduction angle  $\Theta$



**Netz-Thyristor-Modul**  
Phase Control Thyristor Module

**TZ530N**



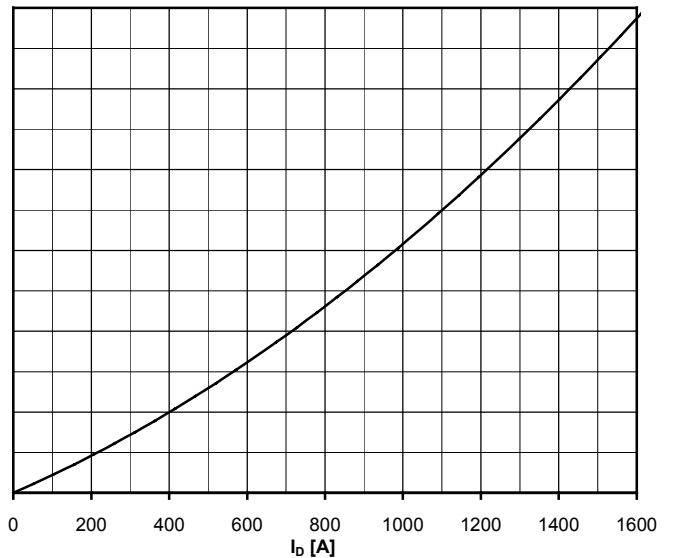
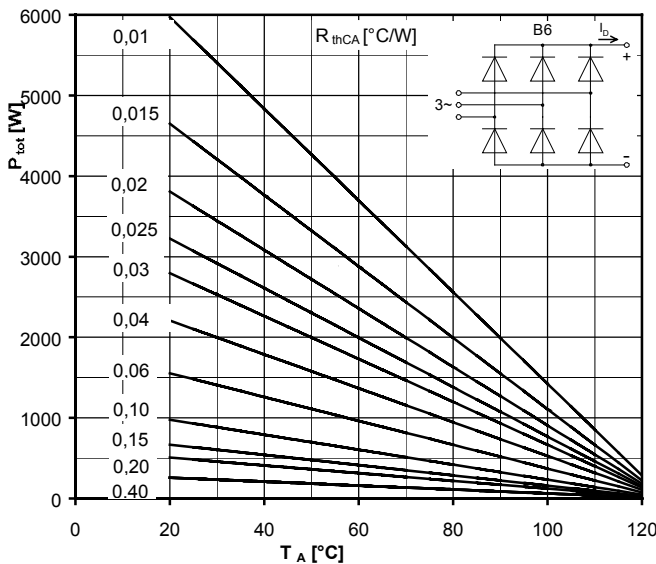
**Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current  $I_D$**

B2- Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

Parameter:

Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient  $R_{thCA}$



**Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current  $I_D$**

B6- Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

Parameter:

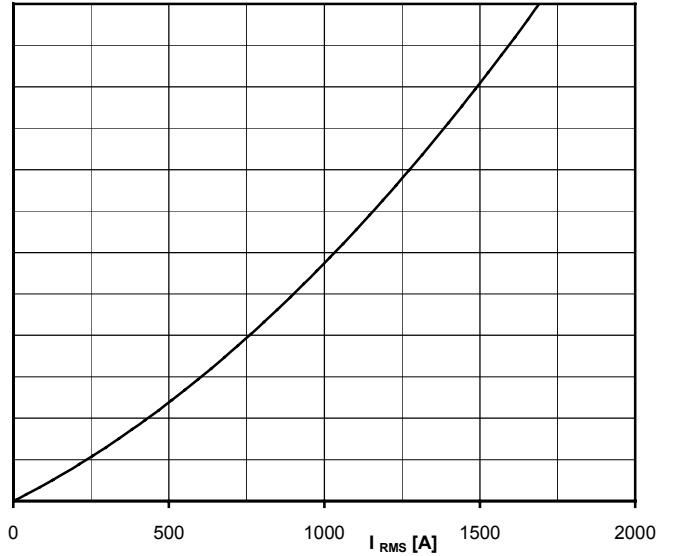
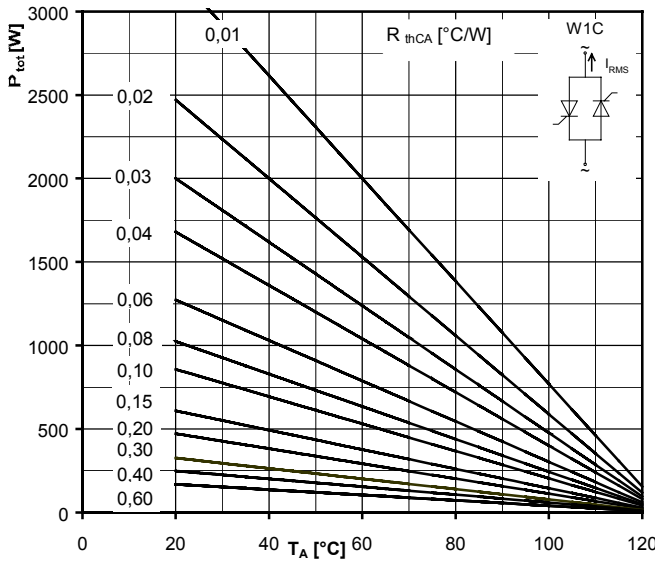
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient  $R_{thCA}$





**Netz-Thyristor-Modul**  
Phase Control Thyristor Module

**TZ530N**



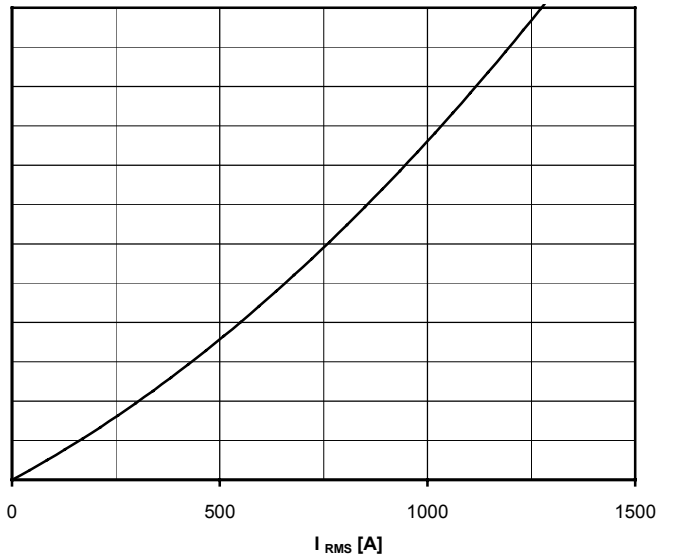
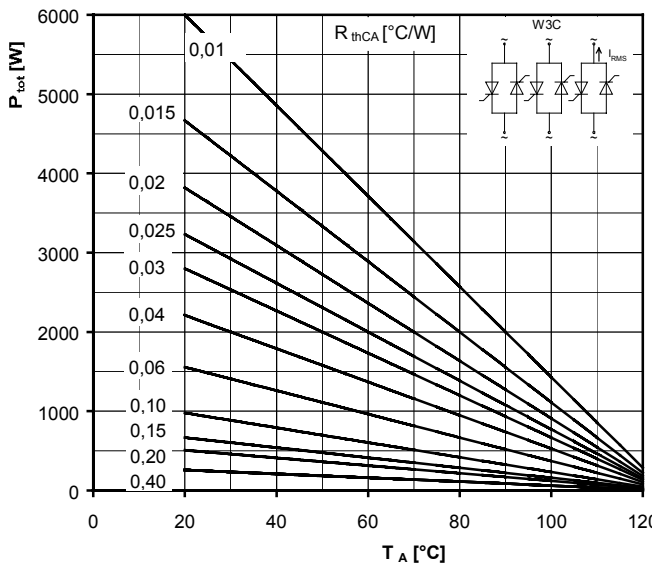
**Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current  $I_{RMS}$**

W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

Parameter:

Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$



**Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current  $I_{RMS}$**

W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

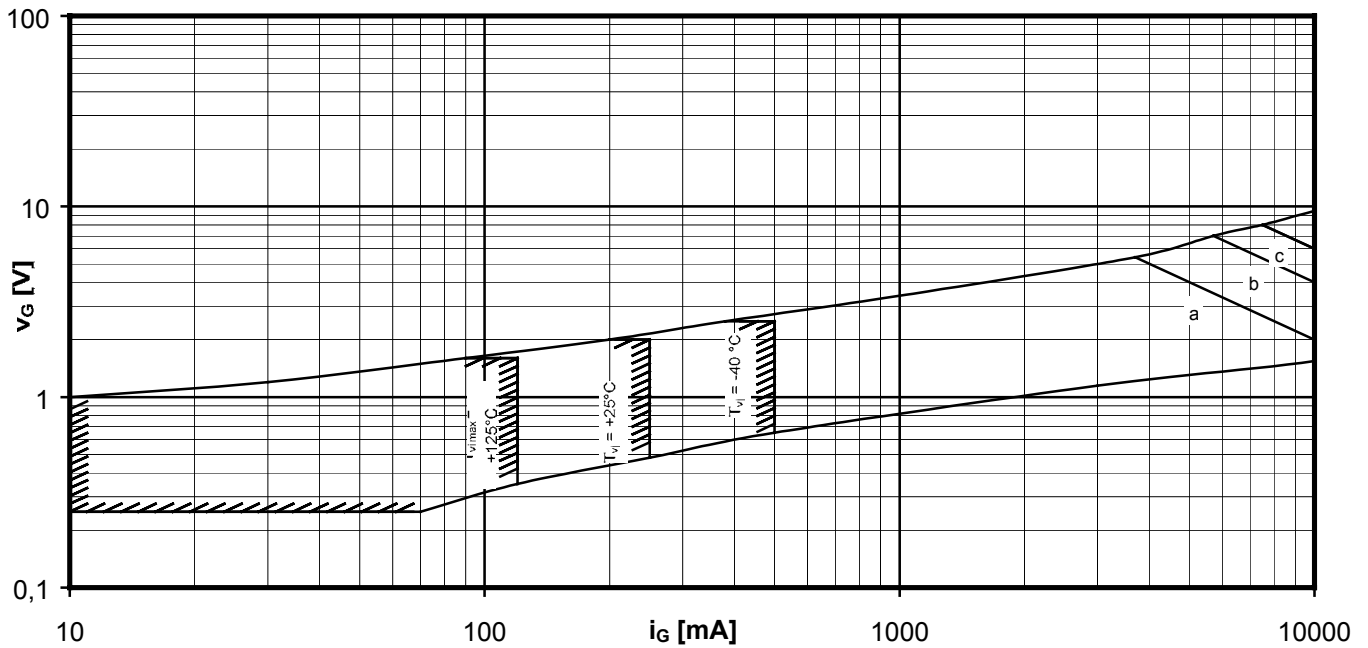
Parameter:

Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient  $R_{thCA}$



Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

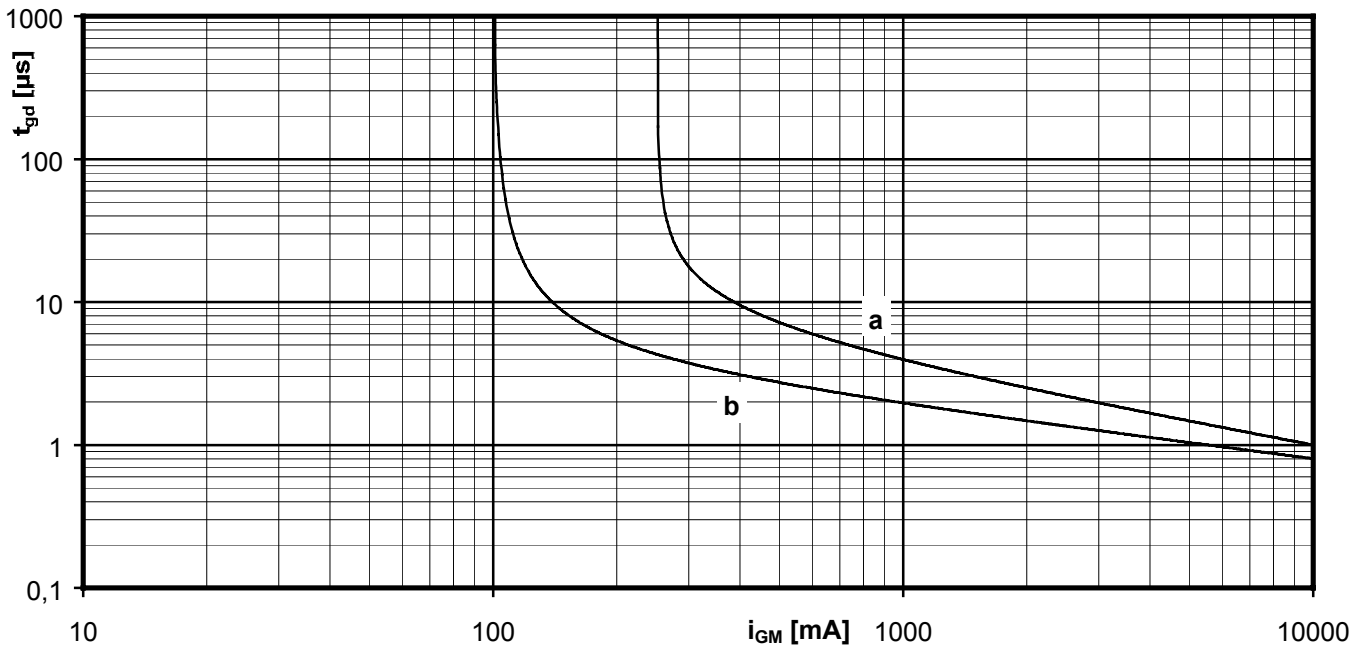
**TZ530N**



Steuercharakteristik  $v_G = f(i_G)$  mit Zündbereichen für  $V_D = 6\text{ V}$   
Gate characteristic  $v_G = f(i_G)$  with triggering area for  $V_D = 6\text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation  $P_{GM} = f(t_g)$  :

a - 20 W/10ms    b - 40 W/1ms    c - 60 W/0,5ms



Zündverzug / Gate controlled delay time  $t_{gd} = f(i_G)$

$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ ,  $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$

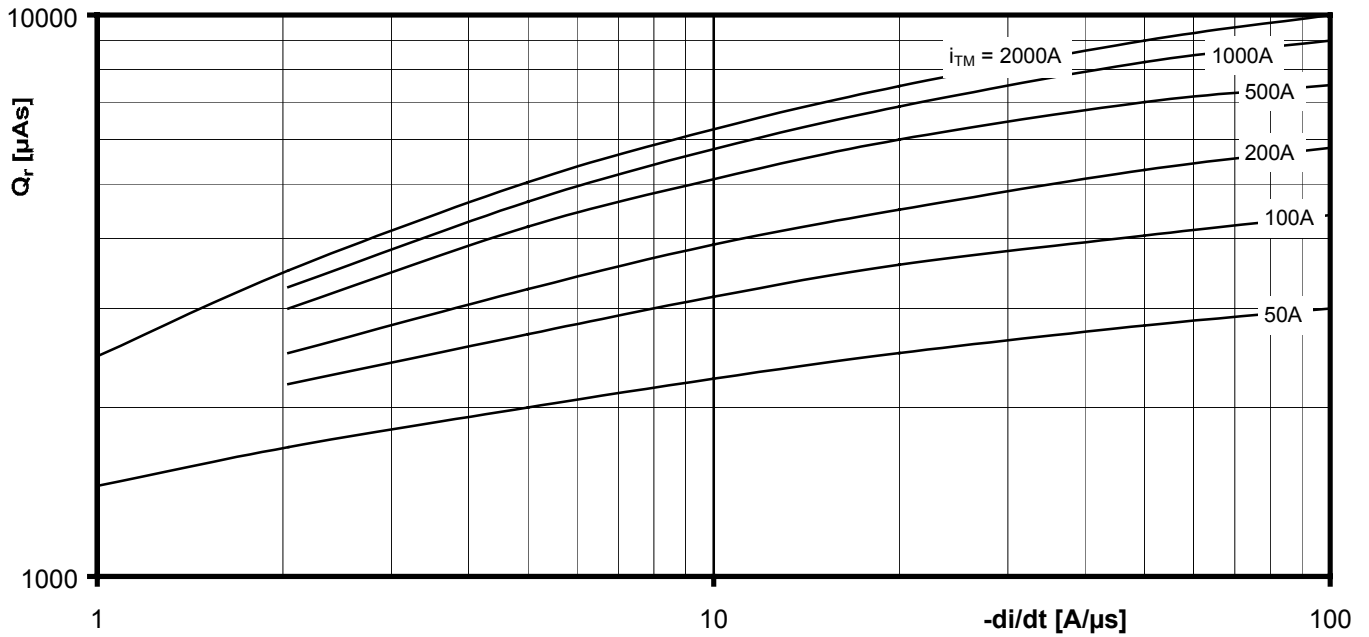
a - maximaler Verlauf / Limiting characteristic

b - typischer Verlauf / Typical characteristic



Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

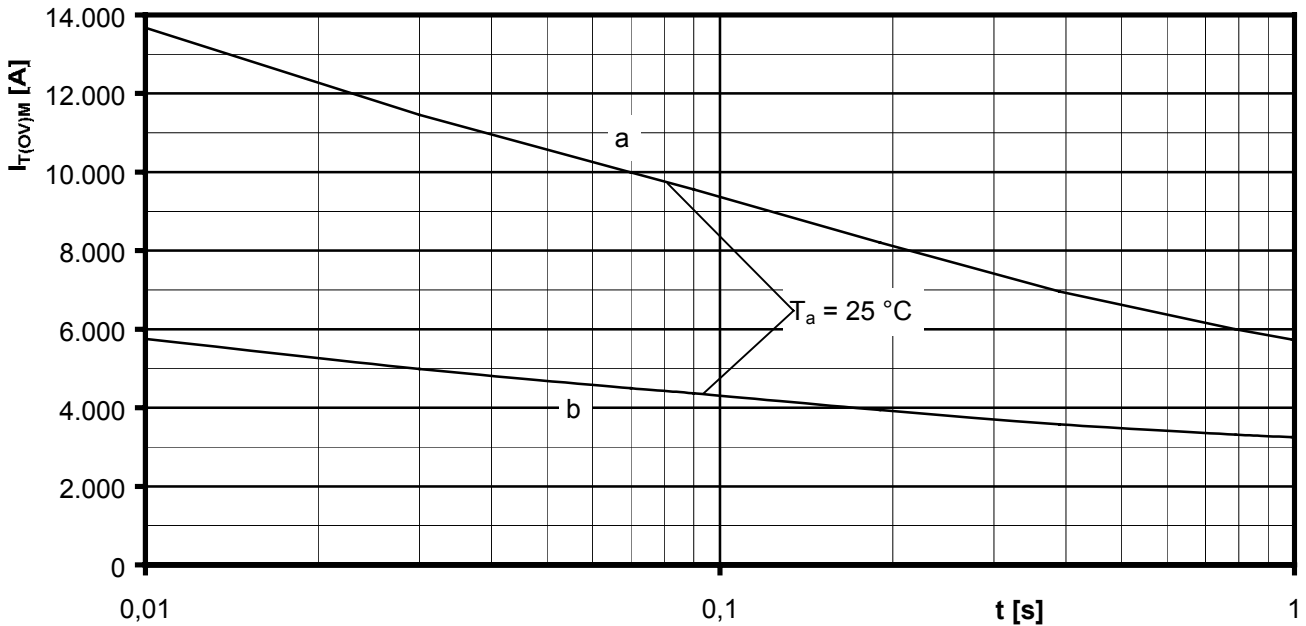
**TZ530N**



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(-di/dt)$

$$T_{vj} = T_{vjmax}, V_R \leq 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current  $i_{TM}$



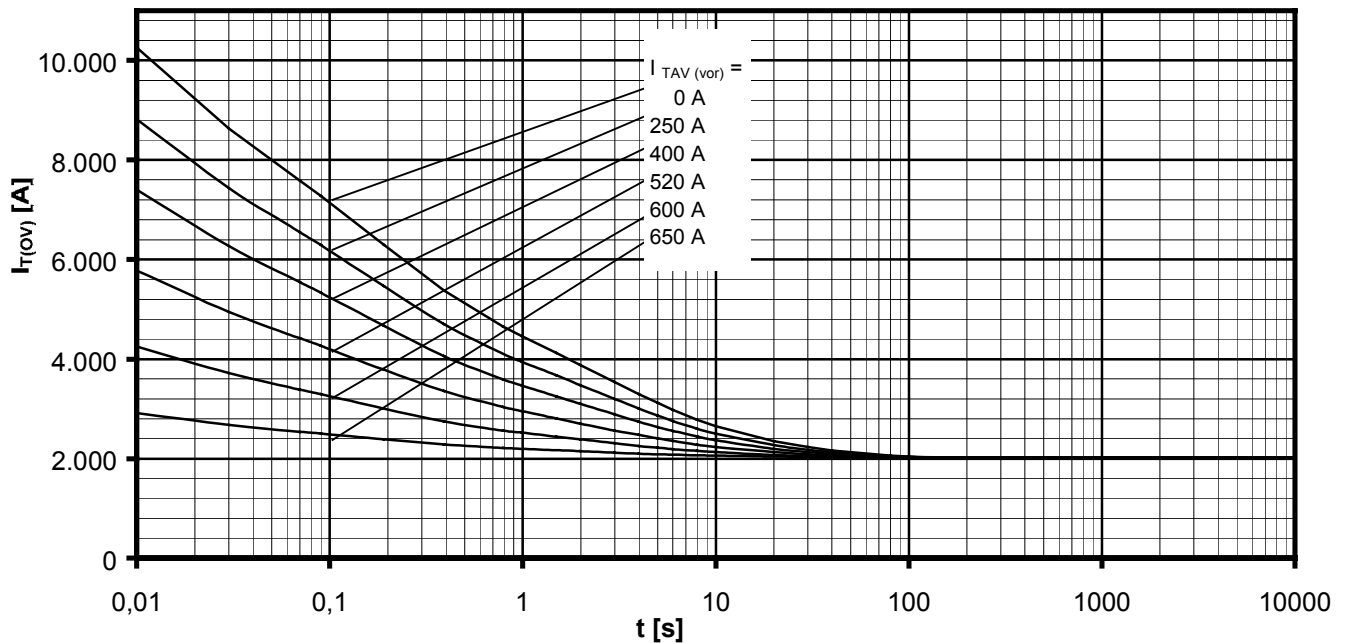
Grenzstrom / Maximum overload on-state current  $I_{T(OV)M} = f(t), V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

a: Leerlauf / No-load conditions  
b: nach Belastung mit  $I_{TAVM}$  / after load with  $I_{TAVM}$   
 $T_A = 25^\circ\text{C}$ , Wasserkühlung / water cooling



Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

**TZ530N**



Überstrom je Zweig / Overload on-state current  $I_{T(OV)}$

B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120° rectangular

Kühlkörper / Heatsink type KW70 ( 4l/min. )    Wasserkühlung / water cooling at  $T_A = 25^\circ\text{C}$

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm  $I_{TAV(vor)}$

## **Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## **Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Infineon:](#)

[TZ530N30KOF](#) [TZ530N32KOF](#) [TZ530N34KOF](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)